

Silicon Diode

BYV63

150V / 6A

DATASHEET

OEM – Telefunken

Source: Telefunken Databook 1988

BYV 61 · BYV 62 · BYV 63

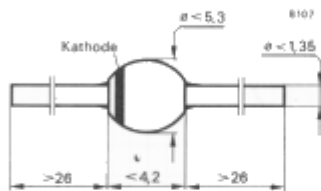
Silizium-Mesa-Dioden

Anwendungen: Sehr schneller Gleichrichter und Schalter, z.B. für Schaltnetzteile

Besondere Merkmale:

- Glaspassivierte Sperrschicht
- Hermetisch dichtes Gehäuse
- ● Auch als "Gütebestätigtes Bauelement" nach ESA-SCC 5000 lieferbar
- Sehr schnelle Schaltzeit
- Niedrige Durchlaßspannung

Abmessungen in mm



Sinterglasgehäuse
Gewicht max. 0,4 g

Bestempfung: Klartext oder TELEFUNKEN electronic Farbkodierung

Absolute Grenzdaten

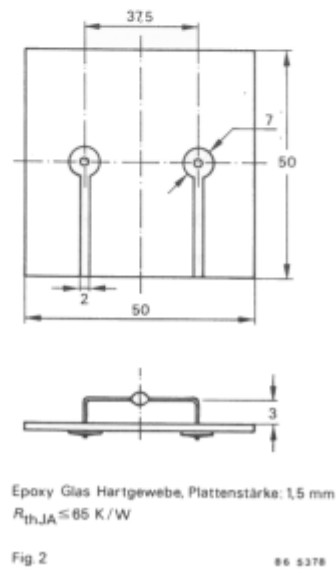
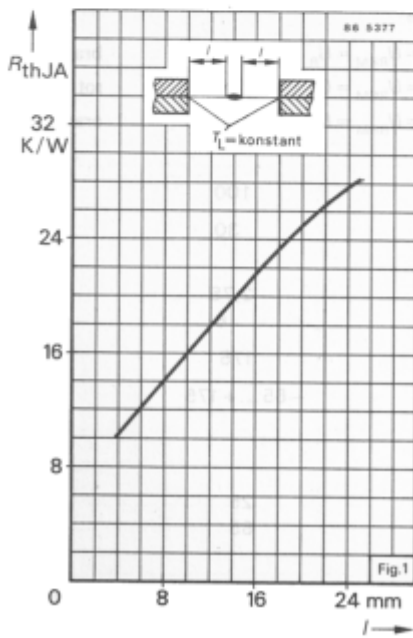
		Kathodenanschluß	1. Farbring blau	2. Farbring
Stoßsperrspannung, Periodische Spitzensperrspannung				
BYV 61	$U_{RSM} = U_{RRM} = U_R$	50 V		braun
BYV 62	$U_{RSM} = U_{RRM} = U_R$	100 V		rot
BYV 63	$U_{RSM} = U_{RRM} = U_R$	150 V		orange
Stoßdurchlaßstrom $t_p = 10 \text{ ms}$	I_{FSM}	100		A
Periodischer Durchlaßspitzenstrom	I_{FRM}	30		A
Durchlaßstrom, Mittelwert $I = 20 \text{ mA}, T_L \leq 25 \text{ °C}$	Fig. 2, 3 Fig. 4 I_{FAV} I_{FAV}	2,75 6		A A
Sperrschichttemperatur	T_L	175		°C
Lagerungstemperaturbereich	T_{stg}	- 65 ... + 175		°C

Maximale Wärmewiderstände

Sperrschicht-Umgebung $I = 20 \text{ mA}, T_L = \text{konstant}$	Fig. 1	R_{thJA}	25	K/W
auf Leiterplatte im Raster 37,5 mm	Fig. 2	R_{thJA}	65	K/W

BYV 61 · BYV 62 · BYV 63

Kenngrößen		Min.	Typ.	Max.
$T_j = 25\text{ °C}$, falls nicht anders angegeben				
Durchlaßspannung				
$I_F = 6\text{ A}$	U_F			1,0 V
$I_F = 6\text{ A}, T_j = 100\text{ °C}$	U_F			0,85 V
Sperrstrom				
$U_R = U_{RRM}$	I_R			5 μA
$U_R = U_{RRM}, T_j = 150\text{ °C}$	I_R			300 μA
Rückwärtserholzeit				
$I_F = 0,5\text{ A}, I_R = 1\text{ A}, i_R = 0,25\text{ A}$	t_{rr}			30 ns



BYV 61 · BYV 62 · BYV 63

